(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-173563

(43)公開日 平成10年(1998)6月26日

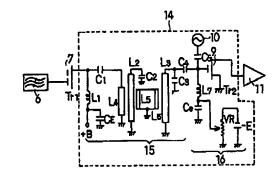
		NAME OF THE	D.1				
(51) Int.CL ⁸		識別配号	F I	. /	•	_	
H04B	1/18			1/18		D	
H03J	7/18		H03J	-			
H 0 4 N	5/44	•		5/44 K			
	7/16			7/16	7/16 A		
			審查請求	未請求	請求項の数3	OL	(全 5 頁)
(21)出顧番月	}	特願平8-335244	(71)出願人	000005049			
•				シャー	7株式会社		
(22)出廣日		平成8年(1996)12月16日		大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			(72) 発明者	松油	松浦修二		
					大阪市阿倍野区: 朱式会社内	長池町22	潘22号 シ
			(74)代理人	-	佐野静夫		

(54) 【発明の名称】 U/Dチューナ

(57)【要約】

【課題】 U/Dチューナにおける第2IFバンドバスフィルタのフィルタ特性を簡単確実に調整できるようにする。

【解決手段】 受信した入力信号を第1中間周波数の信号に変換する第1周波数変換手段4、5と、第1中間周波のバンドバスフィルタ8を備えた第1中間周波増幅回路7、8と、上記バンドバスフィルタ8の出力信号を第2中間周波数の信号に変換するミキサー9と、局部発振器10より成る第2周波数変換手段を設けたダブルコンバージョン方式のU/Dチューナにおいて、上記バンドパスフィルタ8を平面分布定数型のマイクロストリップラインし2、L3、L4、L5とコンデンサC2、C3より成る共振回路で構成し、上記ミキサー9をシングルゲートFETで構成し、このミキサー9の入力ゲートバイアスを可変調整するバイアス可変回路E、VR、L7を設けた構成にする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 受信した高周波信号を第1中間周波信号 に変換する第1局部発掘器と第1ミキサーより成る第1 周波数変換手段と、上記第1中間周波信号を増幅する第 1中間周波増幅手段と、該第1中間周波増幅手段より導 出する第1中間周波信号を第2中間周波信号に変換する 第2局部発振器と第2ミキサーより成る第2周波数変換 手段と、上記第2中間周波信号を増幅する第2中間周波 増幅手段とを設けたダブルコンバージョン方式のU/D チューナにおいて、上記第1中間周波増幅手段に平面分 10 布定数型のマイクロストリップラインで構成したインダ クタンスとコンデンサより成る同調回路を有するバンド パスフィルタ手段を設け、上記第2ミキサーの入力イン ピーダンスを可変調整する入力インピーダンス調整手段 を設け、上記入力インピーダンスの可変で、上記バンド パスフィルタ手段のフィルタ特性を調整するようにした ことを特徴とするU/Dチューナ・

1

【請求項2】 上記第2ミキサーをシングルゲート型F ETで構成したことを特徴とする請求項1記載のU/D チューナ。

【請求項3】 上記インピーダンス調整手段は、上記シ ングルゲート型FETのゲートバイアスを調整するゲー トバイアス調整手段であることを特徴とする請求項2記 載のU/Dチューナ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ケーブルテレビ (以下「CATV」という) の受信端末 (セットトップ ボックス)で多チャンネルのテレビ信号等の受信を行わ ある.

[0002]

【従来の技術】近年CATVはアナログ信号からデジタ ル化の方向へと種々実用化試験が行われており、多チャ ンネル化に拍車をかけている。従来受信帯域は550M Hzまでであったものがデジタルチャンネルが加わり、 750MHz、860MHzへと広帯域になりつつあ る。U/Dチューナは上記のような多チャンネルの信号 を受信するのに最適なチューナであり、CATVの分野 では一般的に広く使用されている。尚、U/Dチューナ 40 は信号を、いったん高い周波数へコンバートし、それか ら低い周波数にコンバートするダブルコンバージョン式 のものである.

【0003】図1は、U/Dチューナの構成図である。 図1において、1はCATVの入力端子であり、50~ 750 MHzの帯域のTV信号が印加される。2は50 ~750MHzのバンドパスフィルタであり、その出力 は高帯域·高周波増幅回路3に導出される。4は第1ミ キサー、5は第1局部発振器であり、上記髙帯域・髙周 波増幅回路3からの信号は、上記第1ミキサー4及び第 50 よれば、中間周波回路14-1における第2IFバンド

1局部発振器5より成る第1周波数変換回路で選局さ れ、950MHzに周波数変換される。

【0004】6は950MHzの第1中間周波数に同調 した第1 I Fバンドパスフィルタであり、7は第1中間 周波増幅器、8は1F同調回路からなる第21Fバンド パスフィルタ、9は第2ミキサー、10は第2局部発振 器であり、上記第2ミキサー9及び第2局部発振器10 よりなる第2周波数変換回路で950MHzから第2中 間周波数の信号に変換される。11は第2中間周波増幅 器、12は第31Fバンドパスフィルタであり、13は 第2中間周波信号の出力端子である。

【0005】図4は、従来例の要部の具体的な構成を示 す回路図であり、上記図1に示すU/Dチューナにおい て、IF同調回路を構成する第2IFバンドパスフィル タ8及び第2ミキサー9と第2局部発振器10より成る 第2周波数変換回路で構成した図中点線の枠で示す中間 周波回路14に対応する部分を詳細に示したものであ ٥.

【0006】図4に示す従来の中間周波回路14-1に 20 おいて、図1に対応する部分には同一符号を付し、説明 を省略する。図4において、L1は高周波チョークコイ ル、L2, L3は中心導体、Zoはトリマー、C1, C 4は結合コンデンサ、C2, C3は同調コンデンサ、C 5は第2局部発振器10と第2ミキサー9-1間に設け た結合コンデンサ、Ceは接地コンデンサ、+Bは電源 電圧である。

【0007】トランジスタTr1より成る第1中間周波増 幅器7-1で増幅された第1中間周波信号は、結合コン デンサC1を介して同調コンデンサC2と中心導体L2 せるU/D (アップ/ダウン)チューナに関するもので 30 及び同調コンデンサC3と中心導体L3より成る共振回 路に導かれる。そして、この共振回路でパンドパスフィ ルタを形成した同調回路を通過した後、結合コンデンサ C4を介し、トランジスタTr2より成る第2ミキサー9 -1に供給され、該第2ミキサー9-1で結合コンデン サC5を介して供給される第2局部発振器10からの第 2局部発振信号と混合され、第2の中間周波信号に周波 数変換される.

> 【0008】バンドパスフィルタを形成する1次側同調 回路はコンデンサC2と中心導体L2で構成され、又、 2次側同調回路はコンデンサC2と中心導体L3で構成 される。そして、上記の各同調回路はトリマー20で上 記中心導体し2,し3との間隔を変えることにより分布 常数回路の特性インピーダンスを変化させ、複同調特性 の調整を行うことができるようになる。上記中心導体し 2及びL3は、図5(a)、(b)に示すように、各々 独立の箇体に設けられ、プリント基板(PWB)上に垂 直に形成し、且つ平行にZoトリマーが配置される。 [0009]

【発明が解決しようとする課題】上記従来の回路構成に

パスフィルタ部の波形調整は、人的手段により、トリマ -Zoを可変して行っており、その調整には熟練を要 し、時間がかかり、コストアップに要因になるという問 題があった。また、バンドパスフィルタを構成する上記 中間周波回路14-1の共振回路が、中心導体とトリマ ーZoより成る分布定数回路の立体構造になっているの で、回路の取り扱いが面倒であるという問題があった。 [0010]

【課題を解決するための手段】上記の問題を解決するた め、本発明の請求項1記載のU/Dチューナは、受信し 10 た髙周波信号を第1中間周波信号に変換する第1局部発 振器と第1ミキサーより成る第1周波数変換手段と、上 記第1中間周波信号を増幅する第1中間周波増幅手段 と、該第1中間周波増幅手段より導出する第1中間周波 信号を第2中間周波信号に変換する第2局部発振器と第 2ミキサーより成る第2周波数変換手段と、上記第2中 間周波信号を増幅する第2中間周波増幅手段とを設けた ダブルコンバージョン方式のU/Dチューナにおいて、 上記第1中間周波増幅手段に平面分布定数型のマイクロ ストリップラインで構成したインダクタンスとコンデン 20 サより成る同調回路を有するバンドパスフィルタ手段を 設け、上記第2ミキサーの入力インピーダンスを可変調 整する入力インピーダンス調整手段を設け、上記入力イ ンピーダンスの可変で、上記バンドパスフィルタ手段の フィルタ特性を調整するようにしたことを特徴とする。 【0011】従って、受信した高周波信号は第1局部発 振器と第1ミキサーより成る第1周波数変換手段で第1 中間周波信号に変換された後、第1中間周波増幅手段で 増幅されて、第2局部発振器と第2ミキサーより成る第 2周波数変換手段に導かれ、ここで第2中間周波信号に 30 変換される。

【0012】上記第1中間周波増幅手段には、平面分布 定数型のマイクロストリップラインで構成したインダク タンスとコンデンサより成る共振回路を有するバンドパ スフィルタ手段が設けられているので、バンドパスフィ ルタ手段により、上記共振回路に同調した周波数特性の 第1中間周波信号が導出され、この第1中間周波信号 は、上記第2ミキサーに供給される。

【0013】第2ミキサーには、入力インピーダンス調 整手段が設けられているので、この入力インピーダンス 40 調整手段を調整すると、上記第2ミキサーの入力インピ ーダンスが変化し、上記パンドパスフィルタ手段のフィ ルタ特性を可変調整することができ、上記第2ミキサー に供給する第1中間周波信号の周波数特性を調整するこ とができる。

【0014】また、本発明の請求項2記載のU/Dチュ ーナは、上記請求項1記載のU/Dチューナにおいて、 第2ミキサーをシングルゲート型FETで構成したこと を特徴とする。

ングルゲート型FETを用いるので、この第2ミキサー の入力インピーダンスの変化量を大きくすることがで き、上記パンドパスフィルタ手段のフィルタ特性の可変 調整範囲を拡げることができる.

【0016】また、本発明の請求項3記載のU/Dチュ ーナは、上記請求項2記載のU/Dチューナにおいて、 上記インピーダンス調整手段は、上記シングルゲート型 FETのゲートバイアスを調整するゲートバイアス調整 手段であることを特徴とする。

【0017】従って、この発明では、シングルゲート型 FETのゲートバイアスをゲートバイアス調整手段によ り可変調整するので、上記シングルゲート型FETの入 カインピーダンスを簡単に調整でき、上記バンドパスフ ィルタ手段のフィルタ特性の調整を簡単な構成で容易に 行うことができる.

[0018]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を説明 する。本発明のU/Dチューナの全体の構成は図1に示 すように、バンドパスフィルタ2、高帯域・高周波増幅 回路3より成る高周波増幅回路と、第1局部発振器5、 第1ミキサー4より成る第1周波数変換回路と、第1Ⅰ Fバンドパスフィルタ6と第1中間周波増幅器7と、第 1 I Fバンドパスフィルタ8及び、第2ミキサー9、第 2局部発振器10より成る第2周波変換回路で構成した 中間周波回路14と、第2中間周波増幅器11と第3Ⅰ Fバンドパスフィルタ12より成る。

【0019】図1に示すU/Dチューナにおいて、本発 明が従来技術と相違する点は、図1中点線の枠で示す中 間周波回路14の構成にあり、その詳細な回路を図2に 示す。図2において、図3に示す従来例に対応する部分 には同一符号を付し、説明を省略する。

【0020】図2に示す中間周波回路14は、バンドバ スフィルタ部15と、第1の中間周波信号を第2の中間 周波信号に変換する周波数変換部16より成る。

【0021】上記バンドパスフィルタ部15は、高周波 チョークコイルL1、接地コンデンサCe、直流阻止用 コンデンサC1、マイクロストリップラインし2、し 3、上記マイクロストリップラインL2への結合用マイ クロストリップラインL4、上記マイクロストリップラ インし2、し3間を結合する結合用マイクロストリップ ラインし5、し6、上記マイクロストリップラインし2 との間で共振回路を形成する共振用コンデンサC2、上 記マイクロストリップラインし3との間で共振回路を形 成する共振用コンデンサC3及び、上記共振回路の出力 を次段のトランジスタTr2で構成する第2のミキサー9 に結合する結合用コンデンサC4より成る。

【0022】上記各マイクロストリップラインL2、L 3. L4, L5, L6は図3に示すように絶縁基板17 上に導体18をパターン化して形成した平面型ストリッ 【0015】従って、この発明では、第2ミキサーにシ 50 プライン (マイクロストリップライン)であり、図5に 示す従来例のような立体型の分布定数線路(ストリップ ライン)とは相違した構成にしている。従って、中間周 波回路 14のパンドパスフィルタがマイクロストリップ ラインより成る平面型分布定数回路で構成されるので、 製造上のバラツキが少なくなり、所望の特性を持つ共振 回路を得ることができる。

【0023】一方、上記中間周波回路14において、第 2の中間周波数の信号に変換する周波数変換部16は、 上記第2ミキサー9を構成するトランジスタTr2と、上 記第2ミキサー9に結合コンデンサC5を介して第2の 10 局部発振周波信号を供給する第2局部発振器10と、上 記第2ミキサー9にバイアス電圧を供給する高周波チョ ークコイルL7、接地コンデンサCe、バイアス電圧調 整用ボリュームVR及びバイアス供給用電源Eにより成 るバイアス調整回路で構成する。

【0024】そして、上記第2ミキサー9を構成するト ランジスタTr2は、従来デュアルゲート型MOSFET を採用していたのに対して、シングルゲート型の接合型 あるいは、MOS型FETにする。これは、シングルゲ インピーダンスが変化し易く、また入力容量Cissが 約2P変化するのに対して相互コンダクタンスGmの変 化が比較的緩やかであり、電力利得では3dB程度の変 化になる。また、ミラー効果により更に変化量を大きく することができるためである.

【0025】本発明の実施形態は、以上のような構成で あるので、トランジスタTrlより成る第1中間周波増幅 器7で増幅された第1中間周波数信号は、中間周波回路 14に供給され、直流阻止用コンデンサC1を介して結 合用マイクロストリップラインL4に入力し、マイクロ 30 【0031】 ストリップラインL2とコンデンサC2より成る1次側 同調回路に導かれる。そして、この1次側同調回路より **夢出される同調出力は、結合用マイクロストリップライ** ンし5、し6を介して、2次側のマイクロストリップラ インし3に誘導され、該マイクロストリップラインし3 と共振用コンデンサC3より成る2次側同調回路で共振 する同調信号が出力される。

【0026】上記共掘用コンデンサC2、C3とマイク ロストリップラインL2、L3より成る1次及び2次側 同調回路は、バンドパスフィルタを形成する。このバン 40 ドパスフィルタの出力は、結合用コンデンサC4を介し て、次段のシングルゲート型FETより成る第2ミキサ -9に入力される。

【0027】第2ミキサー9の入力には、同時に第2局 部発振器10からの第2局部発振周波数信号が結合用コ ンデンサC5を介して供給されている。従って、上記第 2ミキサー9で上記同調回路からの受信信号は第2の中 間周波数の信号に周波数変換され、第2中間周波増幅器 11に供給される。

【0028】上記第2ミキサー9を構成するシングルゲ 50 【図3】 本発明の要部の構成を示す断面図である。

ート型FETのゲート端子には、バイアス電源Eよりバ イアス電圧調整用ポリュームVRで可変分圧したバイア ス電圧が供給されている。従って、上記パイアス電圧調 整用ポリュームVRを調整すると、上記シングルゲート 型FETのゲート端子のバイアス電圧が変化し、このF ETの入力インピーダンスが変化する。このように、上 記シングルゲート型FETの入力インピーダンスが変化 すると、この変化する特性に応じ、上記シングルゲート 型FETに接続される上記の共振用コンデンサC2.C 3及びマイクロストリップラインし2、し3より成る各 同調回路の同調特性は連動して変化する。

【0029】従って、上記バイアス電圧調整用ポリュー ムVRにより上記シングルゲート型FETのゲートに印 加するバイアス電圧を調整することにより、上記各同調 回路の複同調特性の調整を行うことができる。上記のバ イアス電圧調整用ボリュームVRは半固定式であるの で、上記パンドパスフィルタ部15におけるパンドパス 特性の自動調整も可能になる。

【0030】以上のようにシングルゲート型FETのゲ ート型のFETの場合、バイアス電圧の変化により入力 20 ートバイアス電圧を調整して上記FETの入力インビー ダンスを変化させ、上記バンドパスフィルタ部15の複 同調特性を調整するものでは、従来技術で説明したトリ マーZoによりバンドパスフィルタを構成する中心導体 との結合度を調整するものに比べて調整範囲が狭くな る。しかし、絶縁基板上に設けた平面分布定数型のマイ クロストリップラインで共振回路を構成するので、この マイクロストリップラインを高精度に形成することがで き、特性のバラツキを少なくして調整に支障をきたさな いようにすることができる。

【発明の効果】本発明は、以上の構成であるので、第2 ミキサーの入力インピーダンスを可変調整するだけで、 第1中間周波信号の周波数特性を簡単に調整することが でき、調整に要する時間を短縮させることができる。ま た、上記の周波数特性の調整を第2ミキサーの入力バイ アス電圧を可変するだけで行えるので、バラツキが少な く、しかも経時変化の少ない調整を行うことができる。 【0032】また、第2ミキサーの入力バイアス電圧を 調整するだけで、第1中間周波信号の周波数特性を調整 することができるので、調整の自動化を容易に行うこと ができる。更にまた、第1中間周波信号の周波数特性を 定めるバンドパスフィルタの共振手段は平面分布定数型 のマイクロストリップラインとコンデンサで構成されて いるので、構造上の可動部分がなく、製造上のバラツキ の少ない装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 U/Dチューナの全体構成を示すブロック図 である。

【図2】 本発明の要部の構成を示す回路図である。

Q

【図4】 従来例の構成を示す回路図である。

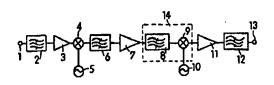
【図5】 従来例の要部の断面図である。

【符号の説明】

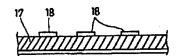
- 2 バンドパスフィルタ
- 3 高帯域·高周波増幅器
- 4 第1ミキサー
- 5 第1局部発振器
- 6 第1 I Fバンドパスフィルタ
- 7 第1中間周波增幅器
- 8 第2 I Fパンドパスフィルタ

- 9 第2ミキサー
- 10 第2局部発振器
- 11 第2中間周波増幅器
- 14 中間周波回路
- L2、L3、L4、L5、L6 中心導体
- C2、C3 共振コンデンサ
- E バイアス電圧
- VR バイアス電圧調整用ボリューム
- 17 絶縁基板
- 10 18 マイクロストリップライン

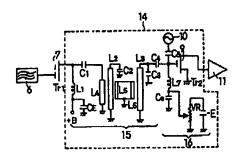
【図1】



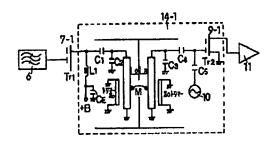
[図3]



【図2】



【図4】



【図5】

